

Список публикаций по теме диссертации оппонента Мармалюка Александра Анатольевича:

1. Асланян А.Э., Авакянц Л.П., Червяков А.В., Туркин А.Н., Мирзаи С.С., Курешов В.А., Сабитов Д.Р., Мармалюк А.А. Исследование напряженности внутренних электрических полей в активной области светодиодных структур на основе InGaN/GaN с разным числом квантовых ям методом спектроскопии электропропускания / Физика и техника полупроводников. 2020. Т. 54. №4. С. 420-425.
2. Асланян А.Э., Авакянц Л.П., Червяков А.В., Туркин А.Н., Курешов В.А., Сабитов Д.Р., Мармалюк А.А. Фотореверсивный ток в светодиодных гетероструктурах на основе InGaN/GaN с разным количеством квантовых ям / Физика и техника полупроводников. 2020. Т. 54. №3. С. 292-295.
3. Зверев М.М., Гамов Н.А., Гладышев Н.И., Жданова Е.В., Локтионов Д.Е., Студенов В.Б., Курешов В.А., Мазалов А.В., Сабитов Д.Р., Падалица А.А., Мармалюк А.А., Козловский В.И., Митюхляев В.Б., Изменение свойств структур AlGaIn/InGaIn/GaN в процессе работы лазеров импульсно-периодического действия на их основе с электронной и оптической накачкой / Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. № 2, 37-41. (2019).
4. Прудаев И.А., Романов И.С., Копьев В.В., Брудный В.Н., Мармалюк А.А., Курешов В.А., Сабитов Д.Р., Мазалов А.В. Влияние короткопериодной сверхрешетки InGaIn/GaN на эффективность светодиодов синего диапазона волн в области высокого уровня оптической накачки / Известия ВУЗов. Физика. 2016. Т. 59. № 7, С. 19-22.
5. Романов И.С., Прудаев И.А., Брудный В.Н., Копьев В.В., Новиков В.А., Мармалюк А.А., Курешов В.А., Сабитов Д.Р., Мазалов А.В. Влияние толщины барьеров светодиодных гетероструктур (0001) InGaIn/GaN/Al₂O₃ на их оптические характеристики / Известия высших учебных заведений. Физика. 2015. Т. 58. № 7. С. 110-113
6. Гамов Н.А., Жданова Е.В., Зверев М.М., Перегудов Д.В., Студенов В.Б., Мазалов А.В., Курешов В.А., Сабитов Д.Р., Падалица А.А., Мармалюк А.А., Импульсный лазер с накачкой электронным пучком на основе квантово-размерной гетероструктуры AlGaIn/InGaIn/GaN / Квантовая электроника. 2015. Т. 45. № 7. С. 601–603.
7. Романов И.С., Прудаев И.А., Брудный В.Н., Копьев В.В., Новиков В.А., Мармалюк А.А., Курешов В.А., Сабитов Д.Р., Мазалов А.В., Светодиодные структуры InGaIn/GaN с короткопериодной сверхрешеткой, выращенные на планарной и профилированной сапфировых подложках / Известия высших учебных заведений. Физика. 57(11), 134-137 (2014).
8. Мазалов А.В., Сабитов Д.Р., Курешов В.А., Падалица А.А., Мармалюк А.А., Акчурина Р.Х., Влияние условий роста на структурное совершенство слоев

AlN, полученных методом МОС–гидридной эпитаксии / Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники (1), 45-48 (2013).

9. Болтарь К.О., Таубкин И.И., Седнев М.В., Чинарева И.В., Лопухин А.А., Смирнов Д.В., Мармалюк А.А., Мазалов А.В., Сабитов Д.Р., Курешов В.А., Падалица А.А., Солнечно-слепые р-і-п-фотодиоды на основе гетероструктур AlGaN/AlN / Прикладная физика (6), 71-75 (2013).
10. Мазалов А.В., Сабитов Д.Р., Курешов В.А., Падалица А.А., Мармалюк А.А., Акчурин Р.Х. Исследование процесса термической активации акцепторной примеси в эпитаксиальных слоях GaN:Mg // Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники (3), 43-46 (2013).